

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การเติร์ยมฟิล์มบางระดับนาโนของแคนเดเมียมซัลไฟด์  
เพื่อการประยุกต์ในเซลล์สุริยะ

ผู้เขียน

นางสาวอุ่รวรรณ อินตีะดา

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศึกษา)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันธศิริ

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการเติร์ยมฟิล์มบางระดับนาโนของแคนเดเมียมซัลไฟด์ที่เจือด้วยทองแดง โดยเทคนิค Chemical bath deposition (CBD) และใช้กระจกไอลด์เป็นแผ่นรอง (substrate) และทำการศึกษาสมบัติต่างๆ ของฟิล์มที่เติร์ยมได้ เช่น ลักษณะสัณฐาน โครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้า และลักษณะทางพื้นผิวของฟิล์ม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าฟิล์มแคนเดเมียมซัลไฟด์ที่เติร์ยมได้ก่อนนำไปให้ความร้อน (unannealed) มีโครงสร้างแบบ cubic และมีลักษณะเป็นอนุภาคทรงกลมขนาด 200 - 400 นาโนเมตร เกาะกันเป็นชั้นบางๆ และมีรูพูนเป็นจำนวนมาก เมื่อนำฟิล์มแคนเดเมียมซัลไฟด์ไปให้ความร้อน (anneal) แล้วมีการเปลี่ยนโครงสร้างเป็น hexagonal และมีรูพูนน้อยลง ส่วนสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มแคนเดเมียมซัลไฟด์พบว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารโดย (ทองแดง) และเพิ่มอุณหภูมิการให้ความร้อน

Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University  
All rights reserved

Author Miss Uraiwan Intatha

Thesis Advisor Prof. Dr. Tawee Tunkasiri

## Abstract

This research reveals the preparation of cadmium sulphide and copper doped cadmium sulphide films using chemical bath deposition technique (CBD). Glass slides were used as substrates. Microstructure, surface characterization and structure of the films were investigated using scanning electron microscopy, atomic force microscopy and x-ray diffraction respectively. Electrical resistance was also studied. The as-deposited films consist of spherical cubic phase particles of 200-400 nm in diameter, appearing to pack together in thin layers with high porosity. Hexagonal cadmium sulphide phase with lower porosity was found in the films after annealing at 400 - 600°C. Resistance of the films decreased with the increasing doping (Cu) ratio and annealing temperature.